

# MENU

SEARCH

# INDEX

## DETAIL

BACK

NEXT

7/10



**JAPANESE PATENT OFFICE**

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 07099321

(43)Date of publication of application: **11.04.1995**

(51)Int.Cl.

H01L 29/786

H01L 21/20

H01L 21/205

H01L 21/324

H01L 21/336

(21)Application number: 05273051

**(71)Applicant:**

**SONY CORP**

(22)Date of filing: 05.10.1993

(72)Inventor:

**HARA MASATERU**

**SANO NAOKI**

**SAMEJIMA TOSHIYUKI**

**KONO ATSUSHI**

SEKIYA MITSUNOBU

KANETANI YASUHIRO

**YANO MICHIHISA**

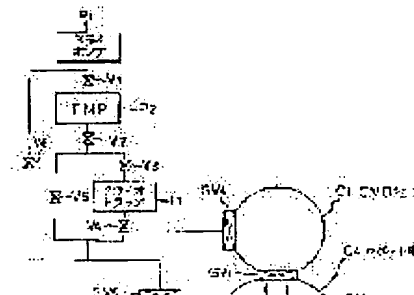
(30)Priority

Priority number: 05148470 Priority date: 27.05.1993 Priority country: JP

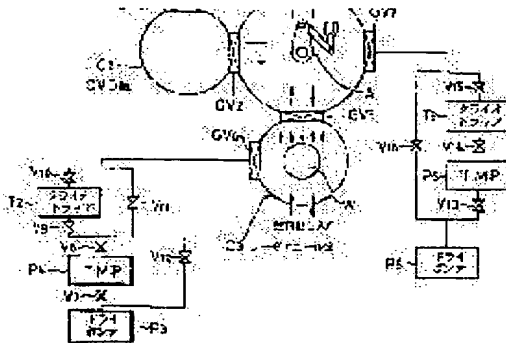
**(54) METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING THIN-FILM SEMICONDUCTOR ELEMENT**

(57)Abstract:

**PURPOSE:** To manufacture a thin-film semiconductor element having high performance and high reliability with excellent uniformity by forming a clean semiconductor/insulating film interface having high quality and hydrogenating a semiconductor thin-film without generating a large change in electric conductivity.



**CONSTITUTION:** An a-Si:H thin-film formed onto a wafer is melted and recrystallized in a laser annealing chamber C3 by the irradiation of laser beams to form a polycrystalline Si thin-film, the wafer is carried into a CVD chamber C1 without exposure to atmospheric air, and a gate insulating film is formed onto the clean surface of the polycrystalline Si thin-film in the CVD chamber C1. The a-Si:H thin-film is melted and recrystallized in the laser annealing chamber C3 to form the polycrystalline Si thin-film, and the wafer is carried into a hydrogenating chamber without exposure in atmospheric air, and the polycrystalline Si thin-film is hydrogenated by plasma in the hydrogenating chamber.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 28.12.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office

[MENU](#)

[SEARCH](#)

[INDEX](#)

[DETAIL](#)

[BACK](#)

[NEXT](#)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-99321

(43) 公開日 平成7年(1995)4月11日

(51) Int.Cl. <sup>9</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 29/786		8122-4M		
21/20				
21/205				
		9056-4M	H 0 1 L 29/ 78	3 1 1 Y
		9056-4M		3 1 1 G
審査請求 未請求 請求項の数17 F D (全 17 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願平5-273051

(22) 出願日 平成5年(1993)10月5日

(31) 優先権主張番号 特願平5-148470

(32) 優先日 平5(1993)5月27日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 原 昌輝

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72) 発明者 佐野 直樹

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72) 発明者 飯島 俊之

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(74) 代理人 弁理士 杉浦 正知

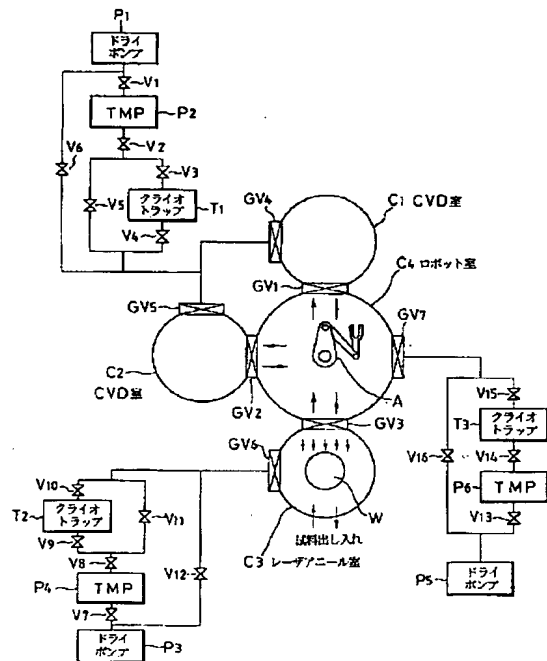
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 薄膜半導体素子の製造方法および製造装置

(57) 【要約】

【目的】 清浄で高品質な半導体/絶縁膜界面を形成し、あるいは電気伝導度の大きな変化を生じることなく半導体薄膜を水素化することにより、高性能かつ高信頼性の薄膜半導体素子を良好な均一性で製造する。

【構成】 ウェハ上に形成されたa-Si:H薄膜をレーザアニール室C<sub>3</sub>内でレーザ光の照射により熔融再結晶化して多結晶Si薄膜を形成した後、大気にさらすことなくウェハをCVD室C<sub>1</sub>内に搬送し、このCVD室C<sub>1</sub>内で多結晶Si薄膜の清浄な表面上にゲート絶縁膜を形成する。また、a-Si:H薄膜をレーザアニール室C<sub>2</sub>内で熔融再結晶化して多結晶Si薄膜を形成した後、大気にさらすことなくウェハを水素化室内に搬送し、この水素化室内で多結晶Si薄膜をプラズマ水素化する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で溶融再結晶化し、

上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜が形成された上記基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま、上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜上に絶縁膜を形成する工程に移るようにしたことを特徴とする薄膜半導体素子の製造方法。

【請求項2】 基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で溶融再結晶化し、

上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜が形成された上記基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま、上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜を水素化する工程に移るようにしたことを特徴とする薄膜半導体素子の製造方法。

【請求項3】 基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で溶融再結晶化し、

上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜が形成された上記基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま、上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜を水素化する工程に移り、

上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜を水素化した後、上記溶融再結晶化および水素化された上記半導体薄膜が形成された上記基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま、上記溶融再結晶化および水素化された上記半導体薄膜上に絶縁膜を形成する工程に移るようにしたことを特徴とする薄膜半導体素子の製造方法。

【請求項4】 上記半導体薄膜に光を照射することにより上記溶融再結晶化を行うようにしたことを特徴とする請求項1、2または3記載の薄膜半導体素子の製造方法。

【請求項5】 上記光はレーザ光であることを特徴とする請求項4記載の薄膜半導体素子の製造方法。

【請求項6】 プラズマCVD法により上記絶縁膜を形成するようにしたことを特徴とする請求項1、3、4または5記載の薄膜半導体素子の製造方法。

【請求項7】 上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜が形成された上記基板を励起された水素ガス雰囲気中に保持することにより上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜を水素化するようにしたことを特徴とする請求項2、3、4または5記載の薄膜半導体素子の製造方法。

【請求項8】 上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜が形成された上記基板を10mTorr以下の圧力の水素ガス雰囲気中に保持し、上記水素ガスを電子サイクロトロン共鳴を用いて励起し、上記励起された上記水素ガスをを用いて上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜を水素化するようにしたことを特徴とする請求項2、3、4

または5記載の薄膜半導体素子の製造方法。

【請求項9】 基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で溶融再結晶化するための第1の処理室と、

上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜上に絶縁膜を形成するための第2の処理室とを有し、

上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜が形成された上記基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま上記第1の処理室から上記第2の処理室に移すように構成されていることを特徴とする薄膜半導体素子の製造装置。

【請求項10】 基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で溶融再結晶化するための第1の処理室と、

上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜を水素化するための第3の処理室とを有し、

上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜が形成された上記基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま上記第1の処理室から上記第3の処理室に移すように構成されていることを特徴とする薄膜半導体素子の製造装置。

【請求項11】 基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で溶融再結晶化するための第1の処理室と、

上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜を水素化するための第3の処理室と、

上記溶融再結晶化および水素化された上記半導体薄膜上に絶縁膜を形成するための第2の処理室とを有し、

上記溶融再結晶化された上記半導体薄膜が形成された上記基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま上記第1の処理室から上記第3の処理室に移すとともに、上記溶融再結晶化および水素化された上記半導体薄膜が形成された上記基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま上記第3の処理室から上記第2の処理室に移すように構成されていることを特徴とする薄膜半導体素子の製造装置。

【請求項12】 上記半導体薄膜に光を照射することにより上記溶融再結晶化を行うようにしたことを特徴とする請求項9、10または11記載の薄膜半導体素子の製造装置。

【請求項13】 上記光はレーザ光であることを特徴とする請求項12記載の薄膜半導体素子の製造装置。

【請求項14】 プラズマCVD法により上記絶縁膜を形成するようにしたことを特徴とする請求項9、11、12または13記載の薄膜半導体素子の製造装置。

【請求項15】 上記第1の処理室は光照射用の窓を有する真空室であることを特徴とする請求項9、10または11記載の薄膜半導体素子の製造装置。

【請求項16】 上記第3の処理室は上記水素ガスの導入口と上記水素ガスを励起するための電極機構とを有す

10

20

30

40

50

る真空室であることを特徴とする請求項10または11記載の薄膜半導体素子の製造装置。

【請求項17】 上記電極機構は平行平板電極を有し、上記平行平板電極のうちの上記半導体薄膜に対向する側の電極はメッシュ電極であることを特徴とする請求項16記載の薄膜半導体素子の製造装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】この発明は、薄膜半導体素子の製造方法および製造装置に関し、例えば薄膜トランジスタ(TFT)の製造に適用して好適なものである。

【0002】

【従来の技術】近年、アクティブ・マトリクス型の液晶ディスプレイにおける画素スイッチング素子などとして、多結晶シリコン(Si)薄膜を用いたTFT(以下「多結晶SiTFT」という)が注目されている。この多結晶SiTFTは、殆ど全ての場合、基板から見て活性層の上側にゲート電極がある、いわゆるトップゲート構造を有する。

【0003】このトップゲート構造を有する多結晶SiTFTの製造においては、基板上にプラズマCVD法により形成された水素化アモルファスSi薄膜(以下「a-Si:H薄膜」という)を真空中で熱や光エネルギーを用いて結晶化することにより多結晶Si薄膜に変えた後、この多結晶Si薄膜上にゲート絶縁膜を形成するのが一般的である。従来、このゲート絶縁膜の形成は、a-Si:H薄膜を多結晶Si薄膜に変えた後に一度真空を破ってから行っている(例えば、Extended Abstracts on SSDM, 967(1990) および応用電子物性分科会研究報告JSAP CatalogNo:AP902204 No.432, 19(1990))。

【0004】一方、結晶性薄膜の欠陥を低減させる方法としてプラズマ水素化が知られており、広く応用されている(IEEE, EDL vol.10(1989)123)。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述のように多結晶Si薄膜形成後に一度真空を破ってしまうと、この多結晶Si薄膜の清浄な表面に水や炭化水素物の分子が吸着して汚染されたり、ガス種との反応により表面が変質(酸化など)してしまう。このように表面が汚染されたり変質したりした多結晶Si薄膜上にゲート絶縁膜を形成すると、トランジスタの性能(オン電流、しきい値電圧、サブスレッショルド・スウィング・ファクターなど)や信頼性(絶縁耐圧など)および均一性(ウェハ内特性)に悪影響が生じるという問題があった。

【0006】一方、結晶性薄膜の欠陥を低減させるために上述の従来のプラズマ水素化を行うときには、特にこの結晶性薄膜が多結晶Si薄膜の場合、その表面にSiO<sub>2</sub>膜が形成されていると、プラズマ水素化の処理によって、この多結晶Si薄膜の電気伝導度が大きく変化し

てしまうことが報告されている(Mat. Res. Symp. Proc. E5,4(1992))。すなわち、上述の従来のプラズマ水素化法においては、レーザ結晶化法を用いて基板上に多結晶Si薄膜を形成し、次にプラズマ水素化を行うときに基板を一旦大気中に取り出すので、このときに多結晶Si薄膜の表面が大気にさらされて自然酸化膜が形成される。そして、この状態で多結晶Si薄膜のプラズマ水素化を行うと、図22に示すように、この多結晶Si薄膜の電気伝導度が数桁も変化する。このような電気伝導度の大きな変化は、薄膜半導体素子の特性のばらつきの原因となり、問題である。

【0007】従って、この発明の目的は、清浄で高品質な半導体/絶縁膜界面を形成することができることにより、高性能かつ高信頼性の薄膜半導体素子を良好な均一性で製造することができる薄膜半導体素子の製造方法および製造装置を提供することにある。

【0008】この発明の他の目的は、電気伝導度の大きな変化を生じることなく半導体薄膜を水素化することができることにより、高性能かつ高信頼性の薄膜半導体素子を良好な均一性で製造することができる薄膜半導体素子の製造方法および製造装置を提供することにある。この発明の上記目的および他の目的は、本明細書の以下の記述より明らかとなるであろう。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、この発明の第1の発明による薄膜半導体素子の製造方法は、基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で溶融再結晶化し、溶融再結晶化された半導体薄膜が形成された基板(1)を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま、溶融再結晶化された半導体薄膜上に絶縁膜を形成する工程に移るようにしている。

【0010】この発明の第2の発明による薄膜半導体素子の製造方法は、基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で溶融再結晶化し、溶融再結晶化された半導体薄膜が形成された基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま、溶融再結晶化された半導体薄膜を水素化する工程に移るようにしている。

【0011】この発明の第3の発明による薄膜半導体素子の製造方法は、基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で溶融再結晶化し、溶融再結晶化された半導体薄膜が形成された基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま、溶融再結晶化された半導体薄膜を水素化した後、溶融再結晶化および水素化された半導体薄膜が形成された基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま、溶融再結晶化および水素化された半導体薄膜上に絶縁膜を形成する工程に移るようにしている。

【0012】この発明の第1の発明、第2の発明および第3の発明による薄膜半導体素子の製造方法において、半導体薄膜の熔融再結晶化は、半導体薄膜にエネルギーを照射することにより行うことができる。具体的には、このエネルギー照射は、レーザー光やランプ（赤外線ランプや紫外線ランプなど）による光などを用いて行うことができる。この発明の第1の発明、第2の発明および第3の発明による薄膜半導体素子の製造方法の好適な一実施形態においては、半導体薄膜にレーザー光を照射することにより熔融再結晶化を行う。

【0013】この発明の第1の発明および第3の発明による薄膜半導体素子の製造方法において、絶縁膜の形成は、例えばCVD法により行うことができる。この発明の第1の発明および第3の発明による薄膜半導体素子の製造方法の好適な一実施形態においては、プラズマCVD法により絶縁膜を形成する。

【0014】この発明の第2の発明および第3の発明による薄膜半導体素子の製造方法においては、典型的には、熔融再結晶化された半導体薄膜が形成された基板を励起された水素ガス雰囲気中に保持することにより、熔融再結晶化された半導体薄膜を水素化する。

【0015】この発明の第2の発明および第3の発明による薄膜半導体素子の製造方法においては、好適には、熔融再結晶化された半導体薄膜が形成された基板を10 mTorr以下の圧力の水素ガス雰囲気中に保持し、水素ガスを電子サイクロトロン共鳴を用いて励起し、励起された水素ガスをを用いて熔融再結晶化された半導体薄膜を水素化する。

【0016】この発明の第4の発明による薄膜半導体素子の製造装置は、基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で熔融再結晶化するための第1の処理室と、熔融再結晶化された半導体薄膜上に絶縁膜を形成するための第2の処理室とを有し、熔融再結晶化された半導体薄膜が形成された基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま第1の処理室から第2の処理室に移すように構成されている。

【0017】この発明の第5の発明による薄膜半導体素子製造装置は、基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で熔融再結晶化するための第1の処理室と、熔融再結晶化された半導体薄膜を水素化するための第3の処理室とを有し、熔融再結晶化された半導体薄膜が形成された基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま第1の処理室から第3の処理室に移すように構成されている。

【0018】この発明の第6の発明による薄膜半導体素子製造装置は、基板上に形成された半導体薄膜の少なくとも表面層を減圧下または不活性ガス雰囲気中で熔融再結晶化するための第1の処理室と、熔融再結晶化された半導体薄膜を水素化するための第3の処理室と、熔融再

結晶化および水素化された半導体薄膜上に絶縁膜を形成するための第2の処理室とを有し、熔融再結晶化された半導体薄膜が形成された基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま第1の処理室から第3の処理室に移すとともに、熔融再結晶化および水素化された半導体薄膜が形成された基板を減圧下または不活性ガス雰囲気中に保持したまま第3の処理室から第2の処理室に移すように構成されている。

【0019】この発明の第4の発明、第5の発明および第6の発明による薄膜半導体素子の製造装置において、半導体薄膜の熔融再結晶化は、この発明の第1の発明、第2の発明および第3の発明による薄膜半導体素子の製造方法と同様に、半導体薄膜にレーザー光やランプ（赤外線ランプや紫外線ランプなど）による光などを照射することにより行うことができる。

【0020】この発明の第4の発明および第6の発明による薄膜半導体素子の製造装置において、絶縁膜の形成は、プラズマCVD法などのCVD法により行うことができる。

【0021】この発明の第4の発明、第5の発明および第6の発明による薄膜半導体素子の製造装置において、第1の処理室は、典型的には、光照射用の窓を有する真空室である。

【0022】この発明の第4の発明および第6の発明による薄膜半導体素子の製造装置において、第3の処理室は、典型的には、水素ガスの導入口と水素ガスを励起するための電極機構とを有する真空室である。好適には、この電極機構は平行平板電極を有し、この平行平板電極のうちの半導体薄膜に対向する側の電極はメッシュ電極である。

【0023】

【作用】この発明の第1の発明による薄膜半導体素子の製造方法によれば、半導体薄膜を熔融再結晶化して多結晶半導体薄膜に変えた後、大気にさらすことなく、この多結晶半導体薄膜の清浄な表面上に絶縁膜を形成することができるので、清浄で高品質な半導体／絶縁膜界面を形成することができ、これによって高性能かつ高信頼性の薄膜半導体素子を良好な均一性で製造することができる。

【0024】この発明の第2の発明による薄膜半導体素子の製造方法によれば、半導体薄膜を熔融再結晶化して多結晶半導体薄膜に変えた後、大気にさらすことなく、この多結晶半導体薄膜の表面を清浄に保ったままこの多結晶半導体薄膜を水素化することができるので、上述の従来のプラズマ水素化法を用いた場合に生じる電気伝導度の異常な変化を防止することができ、これによって高性能かつ高信頼性の薄膜半導体素子を良好な均一性で製造することができる。

【0025】この発明の第3の発明による薄膜半導体素子の製造方法によれば、半導体薄膜を熔融再結晶化して

多結晶半導体薄膜に変えた後、大気にさらすことなく、この多結晶半導体薄膜の清浄な表面上への絶縁膜の形成およびこの多結晶半導体薄膜の水素化を行うことができるので、清浄で高品質な半導体/絶縁膜界面を形成することができるとともに、上述の従来のプラズマ水素化法を用いた場合に生じる電気伝導度の異常な変化を防止することができ、これによって高性能かつ高信頼性の薄膜半導体素子を良好な均一性で製造することができる。

【0026】この発明の第4の発明による薄膜半導体素子の製造装置によれば、この発明の第1の発明による薄膜半導体素子の製造方法と同様に、清浄で高品質な半導体/絶縁膜界面を形成することができることにより、高性能かつ高信頼性の薄膜半導体素子を良好な均一性で製造することができる。

【0027】この発明の第5の発明による薄膜半導体素子の製造装置によれば、この発明の第2の発明による薄膜半導体素子の製造方法と同様に、表面を清浄に保ったまま多結晶半導体薄膜を水素化することができることにより上述の従来のプラズマ水素化法を用いた場合に生じる電気伝導度の異常な変化を防止することができるので、高性能かつ高信頼性の薄膜半導体素子を良好な均一性で製造することができる。

【0028】この発明の第6の発明による薄膜半導体素子の製造装置によれば、この発明の第3の発明による薄膜半導体素子の製造方法と同様に、清浄で高品質な半導体/絶縁膜界面を形成することができ、かつ表面を清浄に保ったまま多結晶半導体薄膜を水素化することができることにより上述の従来のプラズマ水素化法を用いた場合に生じる電気伝導度の異常な変化を防止することができるので、高性能かつ高信頼性の薄膜半導体素子を良好な均一性で製造することができる。

【0029】

【実施例】以下、この発明の実施例について図面を参照しながら説明する。なお、実施例の全図において、同一または対応する部分には同一の符号を付す。

【0030】まず、この発明の実施例において多結晶Si TFTの製造に使用するマルチチャンバー型の薄膜半導体素子製造装置について説明する。

【0031】図1に示すように、この薄膜半導体素子製造装置は、絶縁膜形成用のCVD室C<sub>1</sub>、a-Si:H薄膜形成用のCVD室C<sub>2</sub>、レーザアニール室C<sub>3</sub>、およびこれらの間の試料の搬送を行うロボット室C<sub>4</sub>を有する。ロボット室C<sub>4</sub>においては、ロボットアームAにより試料の搬送が行われる。

【0032】この場合、CVD室C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>は、ドライポンプP<sub>1</sub>、ターボ分子ポンプ(TMP)P<sub>2</sub>およびクライオトラップT<sub>1</sub>を有する真空排気系により真空排気することができるようになっている。V<sub>1</sub>~V<sub>6</sub>はバルブを示す。また、レーザアニール室C<sub>3</sub>は、ドライポンプP<sub>3</sub>、TMPP、およびクライオトラップT<sub>2</sub>を有す

る真空排気系により真空排気することができるようになっている。V<sub>7</sub>~V<sub>12</sub>はバルブを示す。さらに、ロボット室C<sub>4</sub>は、ドライポンプP<sub>4</sub>、TMPP、およびクライオトラップT<sub>3</sub>を有する真空排気系により真空排気することができるようになっている。V<sub>13</sub>~V<sub>16</sub>はバルブを示す。

【0033】CVD室C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>においては、本出願人により先に提案されたりモートプラズマCVD法(特開平5-21393号公報)と呼ばれるプラズマCVD法を用いてそれぞれ絶縁膜およびa-Si:H薄膜の形成が行われる。これらのCVD室C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>の構成の一例を図2に示す。図2において、SWはステンレス鋼製の外壁、QWは石英製の外壁、UEは上部電極、LEは下部電極、MEはメッシュ電極、QRは多数の穴(図示せず)が形成された石英リングを示す。ここで、下部電極LEは接地され、上部電極UEに高周波電力が印加されるようになっている。メッシュ電極MEには可変の電圧が印加される。そして、このCVD室内でリモートプラズマCVDを行うには、下部電極LE上に試料、例えばガラスウェハ1を載せ、このCVD室内にSi原料としてのSiH<sub>4</sub>、ガスなどを外部から導入するとともに、形成すべき膜の種類に応じたガス(Ar、He、N<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>、NH<sub>3</sub>など)を外部から石英リングQR内に導入してその穴からCVD室内に導入し、上部電極UEに高周波電力を印加することによりメッシュ電極MEの上側の空間にプラズマPLを形成し、ガラスウェハ1上に所望の膜を形成する。

【0034】レーザアニール室C<sub>3</sub>の構成の一例を図3に示す。図3において、SWはステンレス鋼製の外壁、UEは上部電極、LEは下部電極、QRは多数の穴が形成された石英リングを示す。上部電極UEは、直線導入機LFにより直線移動することができるようになっている。また、図3において、ORはOリング、Wは石英窓を示す。そして、このレーザアニール室C<sub>3</sub>内でレーザアニールを行うには、下部電極LE上に試料、例えばガラスウェハ1を載せ、雰囲気として用いるガス(Ar、H<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>、Heなど)を外部から石英リングQR内に導入してその穴からレーザアニール室C<sub>3</sub>内に導入し、そのガス雰囲気中で、外部に設けられた例えばエキシマレーザによるレーザ光Lを石英窓Wを通してガラスウェハ1に照射する。この照射時には、直線導入機LFにより上部電極UEを下部電極LEからずれた位置に移動し、この上部電極UEがレーザ光Lの照射の妨げとならないようにする。

【0035】次に、上述のように構成された薄膜半導体素子製造装置を用いて多結晶Si TFTを製造する方法について説明する。

【0036】図4はこの発明の第1実施例によるnチャネル多結晶Si TFTの製造方法を示す。この第1実施例によるnチャネル多結晶Si TFTの製造方法におい

10

20

30

40

50

では、まず、図4Aに示すように、例えば超音波有機洗浄を行った清浄なガラスウェハー1を用意する。

【0037】次に、図4Bに示すように、ガラスウェハー1上に通常のプラズマCVD法によりPドーブのa-Si:H薄膜（以下「a-Si:H、P薄膜」という）2を形成した後、このa-Si:H、P薄膜2をフォトリソグラフィおよびエッチングにより、チャンネル部に対応する部分が除去されるようにパターニングする。このエッチングは例えばドライエッチングにより行われ、この状態における平面図を図5に示す。なお、このa-Si:H、P薄膜2の膜厚は例えば20nmである。

【0038】次に、図4Cに示すように、通常のプラズマCVD法によりa-Si:H薄膜3を形成する。このa-Si:H薄膜3の膜厚は例えば20nmである。

【0039】次に、図4Dに示すように、例えばドライエッチングによりa-Si:H、P薄膜2およびa-Si:H薄膜3をパターニングして島状化する。この状態における平面図を図6に示す。

【0040】次に、図4Dに示すガラスウェハー1を図1に示す薄膜半導体素子製造装置のレーザアニール室C<sub>1</sub>に入れ、このレーザアニール室C<sub>1</sub>内で、図4Eに示すように、例えばエキシマーレーザによるレーザ光Lをa-Si:H、P薄膜2およびa-Si:H薄膜3に照射して熔融再結晶化により多結晶Si薄膜4に変化させる。この際、この多結晶Si薄膜4のうちのチャンネル部となる部分以外の部分には、a-Si:H、P薄膜2中のPがドーピングされることにより、例えばn<sup>+</sup>型のソース領域5およびドレイン領域6が形成される。なお、レーザ光Lとしては、より具体的には、例えばXeClエキシマーレーザによるレーザ光（波長308nm）やKrFエキシマーレーザによるレーザ光（波長248nm）などを用いることができる。

【0041】次に、図4Eに示すガラスウェハー1を、図1に示す薄膜半導体素子製造装置のロボット室C<sub>2</sub>のロボットアームAを用いて、大気にさらすことなく、絶縁膜形成用のCVD室C<sub>3</sub>内に搬送する。そして、このCVD室C<sub>3</sub>内で、図4Fに示すように、例えばSiO<sub>2</sub>膜から成るゲート絶縁膜7をリモートプラズマCVD法により形成する。このゲート絶縁膜7の膜厚は例えば200nmである。

【0042】次に、図4Fに示すガラスウェハー1を図1に示す薄膜半導体素子製造装置のCVD室C<sub>4</sub>から外部に取り出した後、図4Gに示すように、ゲート絶縁膜7の所定部分を例えばウェットエッチングにより除去してコンタクトホール7a、7bを形成する。この状態における平面図を図7に示す。

【0043】次に、図4Gに示すガラスウェハー1の全面に例えばA1膜を真空蒸着などにより形成した後、このA1膜を例えばウェットエッチングによりパターニン

グして、図4Hに示すように、ゲート電極8、ソース電極9およびドレイン電極10を形成する。この状態における平面図を図8に示す。なお、このA1膜の膜厚は例えば100nmである。以上により、目的とするnチャネル多結晶Si TFTが完成する。

【0044】以上のように、この第1実施例によれば、図1に示す薄膜半導体素子製造装置のレーザアニール室C<sub>1</sub>内でレーザ光Lの照射による熔融再結晶化により多結晶Si薄膜4を形成した後、大気にさらすことなくガラスウェハー1をCVD室C<sub>3</sub>内に移動し、このCVD室C<sub>3</sub>内で多結晶Si薄膜4の清浄な表面上にゲート絶縁膜7を形成するようにしているので、多結晶Si薄膜4とゲート絶縁膜7との界面を清浄で高品質なものとすることができる。これによって、性能（オン電流、しきい値電圧、サブスレッショルド・スウィング・ファクターなど）や信頼性（絶縁耐圧など）および均一性（ウェハー内特性）に優れたnチャネル多結晶Si TFTを実現することができる。

【0045】次に、この発明の第2実施例によるnチャネル多結晶Si TFTの製造方法について説明する。図9はこの発明の第2実施例によるnチャネル多結晶Si TFTの製造方法を示す。

【0046】この第2実施例によるnチャネル多結晶Si TFTの製造方法においては、まず、図9Aに示すように、超音波有機洗浄を行った清浄なガラスウェハー1を用意する。

【0047】次に、図9Bに示すように、ガラスウェハー1上に通常のプラズマCVD法によりa-Si:H、P薄膜2を形成した後、このa-Si:H、P薄膜2をフォトリソグラフィおよび例えばドライエッチングのようなエッチングにより、チャンネル部に対応する部分が除去されるようにパターニングする。この状態における平面図は図5に示すと同様である。

【0048】次に、図9Bに示すガラスウェハー1を図1に示す薄膜半導体素子製造装置のCVD室C<sub>2</sub>に入れ、このCVD室C<sub>2</sub>内で、図9Cに示すように、a-Si:H薄膜3をリモートプラズマCVD法により形成する。

【0049】次に、図9Cに示すガラスウェハー1を、図1に示す薄膜半導体素子製造装置のロボット室C<sub>2</sub>のロボットアームAを用いて、大気にさらすことなく、レーザアニール室C<sub>1</sub>内に搬送する。そして、このレーザアニール室C<sub>1</sub>内で、図9Dに示すように、例えばエキシマーレーザによるレーザ光Lをa-Si:H、P薄膜2およびa-Si:H薄膜3に照射して熔融再結晶化により多結晶Si薄膜4に変化させる。この際、この多結晶Si薄膜4のうちのチャンネル部となる部分以外の部分には、a-Si:H、P薄膜2中のPがドーピングされることにより、例えばn<sup>+</sup>型となる。

【0050】次に、図9Dに示すガラスウェハー1を、



図1に示す薄膜半導体素子製造装置のロボット室C<sub>1</sub>のロボットアームAを用いて、大気にさらすことなく、絶縁膜形成用のCVD室C<sub>1</sub>内に搬送する。そして、このCVD室C<sub>1</sub>内で、図9Eに示すように、例えばSiO<sub>2</sub>膜から成るゲート絶縁膜7をリモートプラズマCVD法により形成する。

【0051】次に、図9Eに示すガラスウェハ1を図1に示す薄膜半導体素子製造装置のCVD室C<sub>1</sub>内から外部に取り出した後、図9Fに示すように、例えばドライエッチングにより多結晶Si薄膜4およびゲート絶縁膜7をパターニングして島状化する。この状態における多結晶Si薄膜4のうちのn<sup>+</sup>型の部分がそれぞれソース領域5およびドレイン領域6を構成する。この状態における平面図は図6に示すと同様である。

【0052】次に、図9Gに示すように、ゲート絶縁膜7の所定部分を例えばウェットエッチングにより除去してコンタクトホール7a、7bを形成する。この状態における平面図は図7に示すと同様である。

【0053】次に、図9Gに示すガラスウェハ1の全面に例えばA1膜を真空蒸着などにより形成した後、このA1膜を例えばウェットエッチングによりパターニングして、図9Hに示すように、ゲート電極8、ソース電極9およびドレイン電極10を形成する。この状態における平面図を図10に示す。

【0054】次に、図9Hに示すガラスウェハ1を図1に示す薄膜半導体素子製造装置のCVD室C<sub>1</sub>内に入れ、このCVD室C<sub>1</sub>内で、図9Iに示すように、例えばSiO<sub>2</sub>膜から成る層間絶縁膜11をリモートプラズマCVD法により形成する。この層間絶縁膜11によって、パターニングにより露出した多結晶Si薄膜4の側壁を覆うことができ、その露出を防止することができる。

【0055】次に、図9Jに示すように、層間絶縁膜11の所定部分を例えばウェットエッチングにより除去してコンタクトホール11a、11b、11cを形成する。この状態における平面図を図11に示す。

【0056】次に、図9Jに示すガラスウェハ1の全面に例えばA1膜を真空蒸着などにより形成した後、このA1膜を例えばウェットエッチングによりパターニングする。これによって、図9Kに示すように、目的とする厚さおよび形状のゲート電極8、ソース電極9およびドレイン電極10が形成される。この状態における平面図は図8に示すと同様である。以上により、目的とするnチャネル多結晶Si TFTが完成する。

【0057】以上のように、この第2実施例によれば、a-Si:H薄膜3の形成、熔融再結晶化による多結晶Si薄膜4の形成およびゲート絶縁膜7の形成を、それぞれ図1に示す薄膜半導体素子製造装置のCVD室C<sub>2</sub>、レーザアニール室C<sub>3</sub>およびCVD室C<sub>1</sub>内で、ガラスウェハ1を途中で大気にさらすことなく行って

いるので、多結晶Si薄膜4とゲート絶縁膜7との界面を清浄で高品質なものとすることができるとともに、a-Si:H薄膜3の表面の汚染や変質を防止してこのa-Si:H薄膜3およびa-Si:H、P薄膜2の熔融再結晶化により形成される多結晶Si薄膜4も良質なものとすることができる。これによって、第1実施例と同様に、性能（オン電流、しきい値電圧、サブスレッショルド・スウィング・ファクターなど）や信頼性（絶縁耐圧など）および均一性（ウェハ内特性）に優れたnチャネル多結晶Si TFTを実現することができる。

【0058】ところで、半導体薄膜を多結晶半導体薄膜にする方法としては、半導体薄膜を熔融再結晶化させる方法と、半導体薄膜を固相成長させる方法とがある。後者の半導体薄膜を固相成長させる方法では、大粒径の多結晶半導体薄膜を形成することができるが、固相成長により得られる多結晶半導体薄膜よりも熔融再結晶化により得られる多結晶半導体薄膜の方が膜質が良いことが知られている（例えば、IEEE Trans. Electron Devices vol.38, 2058(1991)）。従って、特性の良好なデバイスを製造するためには、半導体薄膜を熔融再結晶化させるのが良い。この半導体薄膜の熔融再結晶化においては、ガラスウェハ上の半導体薄膜を熔融させる場合には、ガラスの融点が高いことにより基板全体を高温に保つことができないので、半導体薄膜だけを短時間加熱することができるエキシマーレーザなどによるレーザ光の照射が好適に用いられる。

【0059】このように半導体薄膜を短時間熔融した場合に得られる多結晶半導体薄膜中の結晶粒の粒径は、半導体薄膜の膜厚によって制限される。また、出発物質としての半導体薄膜がa-Si:H薄膜のように膜中に多量の水素を含有している場合には、半導体薄膜を熔融させたときに爆発的に水素が放出されて膜が破壊されてしまうおそれがあるため、厚いa-Si:H薄膜ほど、多結晶Si薄膜化するのは困難である（例えば、Extended Abstracts on SSDM, 967(1990)）。このような理由により、例えば300℃程度の低温で、大粒径（例えば、50nm以上）の多結晶Si薄膜をa-Si:H薄膜から得ることは、従来は困難であった。

【0060】この問題を解決するために、熔融させた後の半導体薄膜を一度大気にさらしてから、再度、成膜および熔融を実行することが考えられるが、このようにしても結晶粒の粒径を増大させることはできない。なぜならば、このように半導体薄膜を熔融させた後に大気にさらしてしまうと、多結晶半導体薄膜の清浄な表面に水や炭化水素物の分子が吸着して表面が汚染されたり、ガス種との反応により表面が変質（酸化など）してしまうからである。このように汚染されたり変質したりした部分は結晶粒界となり、結晶成長の際のバリアーとして働くため、粒径の増大が妨げられるのである。

【0061】そこで、この問題を解決し、大粒径の多結

10

20

30

40

50

品半導体薄膜、特に多結晶Si薄膜を形成することができる方法について図12を参照しながら説明する。

【0062】すなわち、まず、例えば超音波有機洗浄を行った清浄なガラスウェハー1を図1に示す薄膜半導体素子製造装置のCVD室C<sub>1</sub>内に入れる。そして、このCVD室C<sub>1</sub>内で、図12Aに示すように、ガラスウェハー1上にa-Si:H薄膜3をリモートプラズマCVD法により形成する。

【0063】次に、図12Aに示すガラスウェハー1を、図1に示す薄膜半導体素子製造装置のロボット室C<sub>2</sub>のロボットアームAを用いて、大気にさらすことなく、レーザアニール室C<sub>3</sub>内に搬送する。そして、このレーザアニール室C<sub>3</sub>内で、図12Bに示すように、例えばエキシマーレーザによるレーザ光Lをa-Si:H薄膜3に照射して熔融再結晶化により多結晶Si薄膜4に変化させる。符号4aは多結晶Si薄膜4中の結晶粒を示す。

【0064】次に、図12Bに示すガラスウェハー1を、図1に示す薄膜半導体素子製造装置のロボット室C<sub>2</sub>のロボットアームAを用いて、大気にさらすことなく、再びCVD室C<sub>1</sub>内に入れる。そして、このCVD室C<sub>1</sub>内で、図12Cに示すように、多結晶Si薄膜4上にa-Si:H薄膜3をリモートプラズマCVD法により形成する。

【0065】次に、図12Cに示すガラスウェハー1を、図1に示す薄膜半導体素子製造装置のロボット室C<sub>2</sub>のロボットアームAを用いて、大気にさらすことなく、再びレーザアニール室C<sub>3</sub>内に搬送する。そして、このレーザアニール室C<sub>3</sub>内で、図12Dに示すように、例えばエキシマーレーザによるレーザ光Lをa-Si:H薄膜3および多結晶Si薄膜4に照射して熔融再結晶化を行わせる。これによって、図12Bに示す多結晶Si薄膜4に比べて厚く、結晶粒4aの粒径も大きい多結晶Si薄膜4が形成される。

【0066】以上のようなa-Si:H薄膜3の形成とレーザ光Lによる熔融再結晶化とを必要な回数だけ繰り返すことにより、大粒径の多結晶Si薄膜4を得ることができる。

【0067】この発明の第3実施例においては、上述のような大粒径の多結晶Si薄膜を形成する方法を用いてnチャネル多結晶Si TFTを製造する。

【0068】この第3実施例によるnチャネル多結晶Si TFTの製造方法においては、第2実施例によるnチャネル多結晶Si TFTの製造方法における図9Bに示す工程までプロセスを進めた後、図1に示す薄膜半導体素子製造装置を用いて、図9Cに示すa-Si:H薄膜3の形成と図9Dに示すレーザ光Lによる熔融再結晶化とを必要な回数だけ繰り返すことにより、十分に大粒径の多結晶Si薄膜4を形成する。例えば、a-Si:H、P薄膜2の膜厚を20nm、一回のリモートプラズ

マCVDにより形成されるa-Si:H薄膜3の膜厚を20nmとし、a-Si:H薄膜3の形成およびその後の熔融再結晶化を3回繰り返した場合には、膜厚が80nm、従って結晶粒4aの粒径が80nm程度と大粒径の多結晶Si薄膜4を形成することができる。

【0069】次に、このようにして大粒径化された多結晶Si薄膜4が形成されたガラスウェハー1を、図1に示す薄膜半導体素子製造装置のレーザアニール室C<sub>3</sub>からCVD室C<sub>1</sub>に大気にさらすことなく搬送する。そして、このCVD室C<sub>1</sub>内で、図9Eに示すと同様に、多結晶Si薄膜4の清浄な表面上にゲート絶縁膜7を形成する。この後、図9F～図9Kと同様にプロセスを進め、目的とするnチャネル多結晶Si TFTを完成させる。

【0070】以上のように、この第3実施例によれば、第2実施例によるnチャネル多結晶Si TFTの製造プロセスに、図12に示す多結晶Si薄膜の大粒径化のプロセスを加えていることにより、特に電界効果移動度が例えば $50\text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 以上と高い高性能のnチャネル多結晶Si TFTを実現することができる。

【0071】次に、この発明の第4実施例について説明する。図13はこの第4実施例において用いる薄膜半導体素子製造装置を示す。図13に示すように、この薄膜半導体素子製造装置は、レーザ光Lの照射用の窓Wを有するレーザアニール室C<sub>3</sub>と、外部から導入される水素(H<sub>2</sub>)をプラズマ化するための互いに対向した上部電極U E'および下部電極L E'を有する水素化室C<sub>4</sub>とを有し、これらのレーザアニール室C<sub>3</sub>および水素化室C<sub>4</sub>が、図示省略した真空搬送系を介して結合された構成を有する。これらのレーザアニール室C<sub>3</sub>および水素化室C<sub>4</sub>は、それぞれ図示省略した真空排気系により例えば $2 \times 10^{-7}\text{ Torr}$ 程度の圧力に真空排気可能となっている。

【0072】このように構成された図13に示す薄膜半導体素子製造装置によれば、まず、あらかじめ例えばa-Si:H薄膜3が形成されたガラスウェハー1をレーザアニール室C<sub>3</sub>内に入れ、このレーザアニール室C<sub>3</sub>内で、石英窓Wを介してa-Si:H薄膜3にレーザ光Lを照射して熔融再結晶化により多結晶Si薄膜4を形成した後、真空を破ることなく、ガラスウェハー1を水素化室C<sub>4</sub>内に搬送する。そして、この水素化室C<sub>4</sub>内で、上部電極U E'に高周波電力を印加することによりこの上部電極U E'と下部電極L E'との間に発生された水素プラズマにより、上述の熔融再結晶化により得られた多結晶Si薄膜4のプラズマ水素化を行う。

【0073】図14は上述のようにして熔融再結晶化およびプラズマ水素化を行うことにより得られた厚さ20nmの多結晶Si薄膜4の暗伝導度および光伝導度のプラズマ水素化時の水素ガス圧力依存性を測定した結果を示す。ただし、プラズマ水素化の条件は、水素ガス流量

10

20

30

40

50

100 sccm、温度270℃、高周波電力5Wおよび水素化時間30秒である。また、図15は上述のようにして熔融再結晶化およびプラズマ水素化を行うことにより得られた厚さ20nmの多結晶Si薄膜4の暗伝導度および光伝導度のプラズマ水素化時の水素化時間依存性を測定した結果を示す。ただし、プラズマ水素化の条件は、水素ガス流量100 sccm、温度270℃、高周波電力5Wおよび水素ガス圧力0.5 Torrである。

【0074】図14からわかるように、水素ガス圧力が約0.5 Torr以上で光伝導度が大きくなっており、このことからレーザ光Lによる熔融再結晶化の際に多結晶Si薄膜4中に発生した欠陥が減少していることが確認された。また、図15からわかるように、水素化時間は約30秒以上であれば、良好なプラズマ水素化を行うことができる。さらに、図14および図15に示す特性には、図22に示したような電気伝導度の異常な変化は見られないことから、安定した水素化が行われたことがわかる。これは、上述のような真空中一貫プロセスにより、表面が清浄に保たれたまま多結晶Si薄膜4のプラズマ水素化が行われたことを示す。

【0075】以上のように、この第4実施例によれば、レーザアニール室C、内でa-Si:H薄膜3の熔融再結晶化を行った後、これにより得られた多結晶Si薄膜4の表面を清浄に保ったまま水素化室C、内でこの多結晶Si薄膜4のプラズマ水素化を行うことができるので、すでに述べた従来のプラズマ水素化法を用いた場合に生じる多結晶Si薄膜4の電気伝導度の異常な変化をなくすることができる。そして、この多結晶Si薄膜4を用いてTFTなどの薄膜半導体素子を形成することにより、薄膜半導体素子の特性のばらつきを抑えることができる。

【0076】次に、この発明の第5実施例について説明する。図16はこの第5実施例において用いる薄膜半導体素子製造装置を示す。図16に示すように、この薄膜半導体素子製造装置は、レーザアニール室と水素化室とが一体化された単一のレーザアニールおよび水素化室Cを有する。このレーザアニールおよび水素化室Cは、図示省略した真空排気系により例えば $2 \times 10^{-7}$  Torr程度の圧力に真空排気可能になっている。このレーザアニールおよび水素化室Cにおいては、図示省略した直線導入機により図16中左右方向に移動可能なプラズマ放電用の上部電極UE"が設けられている。図示は省略するが、この場合、ガラスウェハ1は下部電極上に置かれている。なお、このレーザアニールおよび水素化室Cは、より具体的には、図3に示すレーザアニール室Cと同様に構成することができる。

【0077】このように構成された図16に示す薄膜半導体素子製造装置によれば、レーザアニールおよび水素化室C、内で、まず、上部電極UE"をガラスウェハ1の上方から外れた位置に移動させた状態で、ガラスウ

ェハ1上にあらかじめ形成された例えばa-Si:H薄膜3に石英窓Wを介してレーザ光Lを照射して熔融再結晶化を行う。次に、上部電極UE"をガラスウェハ1の上方に移動させた後、レーザアニールおよび水素化室C、内に水素ガスを導入する。次に、この上部電極UE"に高周波電力を印加することにより水素ガスのプラズマ放電を起こさせ、上述の熔融再結晶化により形成された多結晶Si薄膜のプラズマ水素化を行う。

【0078】この第5実施例によっても、第4実施例と同様に、a-Si:H薄膜3の熔融再結晶化を行った後、これにより得られる多結晶Si薄膜の表面を清浄に保ったままこの多結晶Si薄膜のプラズマ水素化を行うことができるので、この多結晶Si薄膜の電気伝導度の異常な変化が生じるのを防止することができる。

【0079】次に、この発明の第6実施例について説明する。図17はこの第6実施例において用いる薄膜半導体素子製造装置を示す。図17に示すように、この薄膜半導体素子製造装置は、水素化室C、内の下部電極がメッシュ電極ME'となっており、上部電極UE'とこのメッシュ電極ME'との間に水素プラズマPL'を発生させることができるようになっている。その他の構成は第4実施例において用いた図13に示す薄膜半導体素子製造装置と同様であるので、説明を省略する。

【0080】このように構成された図17に示す薄膜半導体素子製造装置によれば、まず、レーザアニール室C、内で、ガラスウェハ1上のa-Si:H薄膜3にレーザ光Lを照射して熔融再結晶化を行った後、真空を破ることなくガラスウェハ1を水素化室C、内に搬送し、この水素化室C、内で、上部電極UE'およびメッシュ電極ME'間に発生された水素プラズマにより、上述の熔融再結晶化により得られた多結晶Si薄膜4のリモートプラズマ水素化を行う。

【0081】この第6実施例によれば、第4実施例と同様に、多結晶Si薄膜4のプラズマ水素化により電気伝導度の異常な変化が生じるのを防止することができるほか、次のような利点も得ることができる。すなわち、この第6実施例においては、プラズマ水素化に用いられる水素プラズマPL'は上部電極UE'およびメッシュ電極ME'間に閉じ込められるため、プラズマ水素化時に高エネルギーのイオンが多結晶Si薄膜4に照射されることがない。そして、電荷のない中性の水素原子のみがメッシュ電極ME'を通して多結晶Si薄膜4の水素化に寄与する。このため、プラズマ水素化時に多結晶Si薄膜4に欠陥が発生するのを防止することができる。

【0082】次に、この発明の第7実施例について説明する。図18はこの第7実施例において用いる薄膜半導体素子製造装置を示す。図18に示すように、この薄膜半導体素子製造装置は、電子サイクロトロン共鳴(ECR)を利用して水素プラズマを発生させるプラズマガンPGを有し、このプラズマガンPGにより発生される水

10

20

30

40

50

素プラズマによりプラズマ水素化を行う水素化室C<sub>1</sub>を有する。MGは電磁石を示す。その他の構成は第4実施例において用いた図13に示す薄膜半導体素子製造装置と同様であるので、説明を省略する。

【0083】このように構成された図18に示す薄膜半導体素子製造装置によれば、まず、レーザアニール室C<sub>1</sub>内で、ガラスウェハー1上にあらかじめ形成されたa-Si:H薄膜3にレーザ光Lを照射して熔融再結晶化を行った後、真空を破ることなくガラスウェハー1を水素化室C<sub>1</sub>内に搬送し、この水素化室C<sub>1</sub>内で、プラズマガンPGにより発生された水素プラズマにより、上述の熔融再結晶化により得られた多結晶Si薄膜4のプラズマ水素化を行う。

【0084】この第7実施例によれば、第4実施例と同様に、多結晶Si薄膜4のプラズマ水素化により電気伝導度の異常な変化が生じるのを防止することができるほか、次のような利点も得ることができる。すなわち、この第7実施例においては、水素プラズマを発生させるために、マイクロ波による励起と電磁石MGによる共鳴現象とを用いたECRを利用して水素ガスの励起を行っているので、水素ガスの励起効率を高くすることができ、これによってプラズマ水素化を高い効率で行うことができる。また、このようにECRを利用してプラズマ水素化を行うことにより、通常のプラズマ水素化法では実現することが困難な、10mTorr以下の低圧力下でのプラズマ水素化が可能である。

【0085】次に、この発明の第8実施例について説明する。図19はこの第8実施例において用いる薄膜半導体素子製造装置を示す。図19に示すように、この薄膜半導体素子製造装置は、第6実施例において用いた図17に示す薄膜半導体素子製造装置の水素化室C<sub>1</sub>に、絶縁膜を形成するためのCVD室C<sub>2</sub>が、図示省略した真空搬送系を介してさらに結合された構成を有する。このCVD室C<sub>2</sub>においては、下部電極はメッシュ電極MEにより構成されている。そして、このCVD室C<sub>2</sub>内に絶縁膜の形成に必要なガスを導入し、上部電極UEに高周波電力を印加してこの上部電極UEとメッシュ電極MEとの間にプラズマを発生させることによりリモートプラズマCVDが行われるようになっている。

【0086】このように構成された図19に示す薄膜半導体素子製造装置によれば、まず、レーザアニール室C<sub>1</sub>内で、ガラスウェハー1上にあらかじめ形成されたa-Si:H薄膜3にレーザ光Lを照射して熔融再結晶化を行った後、真空を破ることなくガラスウェハー1を水素化室C<sub>1</sub>内に搬送し、この水素化室C<sub>1</sub>内で、上部電極UEおよびメッシュ電極ME間に発生された水素プラズマにより、上述の熔融再結晶化により得られた多結晶Si薄膜4のリモートプラズマ水素化を行う。次に、真空を破ることなくガラスウェハー1をCVD室C<sub>2</sub>内に搬送し、このCVD室C<sub>2</sub>内で、上部電極UEお

よびメッシュ電極ME間に発生されたプラズマを用いて多結晶Si薄膜4上にリモートプラズマCVD法により例えばSiO<sub>2</sub>膜12を形成する。

【0087】この第8実施例によれば、a-Si:H薄膜3の熔融再結晶化を行った後にこれにより得られる多結晶Si薄膜4の表面を清浄に保ったままこの多結晶Si薄膜4のプラズマ水素化を行うことができるとともに、プラズマ水素化を行った多結晶Si薄膜4の表面を清浄に保ったままこの多結晶Si薄膜4上にSiO<sub>2</sub>膜12を形成することができるので、プラズマ水素化により多結晶Si薄膜4の電気伝導度の異常な変化が生じるのを防止することができるとともに、清浄で高品質な多結晶Si薄膜/SiO<sub>2</sub>膜界面を形成することができる。

【0088】図20はこの発明の第9実施例によるpチャンネル多結晶Si TFTの製造方法を示す。

【0089】この第9実施例によるpチャンネル多結晶Si TFTの製造方法においては、まず、図20Aに示すように、例えば超音波有機洗浄を行った清浄なガラスウェハー1を用意する。

【0090】次に、図20Bに示すように、ガラスウェハー1上に通常のプラズマCVD法によりBドープのa-Si:H薄膜（以下「a-Si:H、B薄膜」という）13を形成し、このa-Si:H、B薄膜13をフォトリソグラフィおよびエッチングにより、チャンネル部に対応する部分が除去されるようにパターニングする。

【0091】次に、図20Cに示すように、通常のプラズマCVD法によりa-Si:H薄膜3を形成する。

【0092】次に、図20Dに示すように、例えばドライエッチングによりa-Si:H、B薄膜13およびa-Si:H薄膜3をパターニングして島状化する。

【0093】次に、図20Dに示すガラスウェハー1を図19に示す薄膜半導体素子製造装置のレーザアニール室C<sub>1</sub>に入れ、このレーザアニール室C<sub>1</sub>内で、図20Eに示すように、例えばエキシマーレーザによるレーザ光Lをa-Si:H、B薄膜13およびa-Si:H薄膜3に照射して熔融再結晶化により多結晶Si薄膜4に変化させる。この際、この多結晶Si薄膜4のうちのチャンネル部となる部分以外の部分には、a-Si:H、B薄膜13中のBがドーピングされることにより、例えばp<sup>+</sup>型のソース領域14およびドレイン領域15が形成される。ここで、レーザ光Lとしては、より具体的には、例えばXeClエキシマーレーザによるレーザ光（波長308nm）やKrFエキシマーレーザによるレーザ光（波長248nm）などを用いることができる。

【0094】上述のようにして熔融再結晶化により多結晶Si薄膜4を形成した後、レーザアニール室C<sub>1</sub>において、上部電極UEをガラスウェハー1の上方に移動させる。次に、レーザアニール室C<sub>1</sub>内に水素ガスを導

10

20

30

40

50

入した後、上部電極UEに高周波電力を印加して放電を起こさせることにより水素プラズマを形成し、これによって多結晶Si薄膜4のプラズマ水素化を行う。

【0095】次に、図20Eに示すガラスウェハー1を、真空を破ることなく、すなわち大気にさらすことなく、図19に示す薄膜半導体素子製造装置の絶縁膜形成用のCVD室C<sub>1</sub>、内に搬送する。そして、このCVD室C<sub>1</sub>内で、図20Fに示すように、例えばSiO<sub>2</sub>膜から成るゲート絶縁膜7をリモートプラズマCVD法により形成する。

【0096】次に、図20Fに示すガラスウェハー1を図19に示す薄膜半導体素子製造装置のCVD室C<sub>1</sub>から外部に取り出した後、図20Gに示すように、ゲート絶縁膜7の所定部分を例えばウェットエッチングにより除去してコンタクトホール7a、7bを形成する。

【0097】次に、図20Gに示すガラスウェハー1の全面に例えばA1膜を真空蒸着などにより形成した後、このA1膜を例えばウェットエッチングによりパターニングして、図20Hに示すように、ゲート電極8、ソース電極9およびドレイン電極10を形成する。なお、このA1膜の膜厚は例えば100nmである。以上により、目的とするpチャネル多結晶Si TFTが完成する。

【0098】図21は上述のようにして製造されたpチャネル多結晶Si TFTのドレイン電流-ゲート電圧特性を測定した結果を示す。ただし、このpチャネル多結晶Si TFTのゲート幅は20μm、ゲート長は10μm、ゲート絶縁膜2を構成するSiO<sub>2</sub>膜の厚さは120nmであり、ドレイン電圧は1Vである。図20からわかるように、多結晶Si薄膜4のプラズマ水素化により電気伝導度の異常な変化が起こらないため、しきい値電圧が約-1.8Vと小さい、良好な特性が得られている。

【0099】以上、この発明の実施例について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施例に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。

【0100】例えば、図1に示す薄膜半導体素子製造装置は処理室としてCVD室C<sub>1</sub>、CVD室C<sub>2</sub>およびレーザアニール室C<sub>3</sub>を有しているが、これらに加えて、例えば、化学的表面処理を行う処理室やCVD法以外の方法による成膜室を設けてもよい。ここで、化学的表面処理とは、プラズマ水素化などのプラズマ処理、ガスフロー処理、光処理などをいう。また、CVD法以外の方法による成膜室とは、スパッター室や蒸着室などをいう。

【0101】また、例えば、図1に示す薄膜半導体素子製造装置に、プラズマ重合などによりフォトレジストを形成するフォトレジスト形成室、フォトレジスト露光室およびフォトレジストの露光領域または非露光領域を選

択に除去し、あるいは露光の有無にかかわらずフォトレジスト全体を除去するフォトレジスト除去室を追加すれば、上述の実施例における各種のパターニングを行う際に用いられるフォトレジストパターンの形成およびその除去も、ガラスウェハー1を大気にさらすことなく、連続的に行うことができる。さらに、これに加えて、a-Si:H、P薄膜を形成するCVD室、エッチング室およびA1膜の蒸着室を設ければ、製造途中でガラスウェハー1を大気にさらすことなく、多結晶Si TFTを製造することも可能である。

【0102】なお、例えば、一つの処理室に複数の処理機能を持たせ、この処理室内で連続的に複数の処理を行うようにしてもよい。第5実施例において用いた図16に示す薄膜半導体素子製造装置はその一例であるが、これ以外に、例えば、図1に示す薄膜半導体素子製造装置におけるレーザアニール室C<sub>3</sub>とCVD室C<sub>1</sub>との両機能を併せ持つ一つの処理室内で、レーザアニールと絶縁膜の形成とを連続的に行うようにしてもよい。

【0103】また、この発明は、Si薄膜以外の各種半導体薄膜を用いた薄膜半導体素子の製造に適用することが可能である。

【0104】

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、清浄で高品質の半導体/絶縁膜界面を形成することができることにより、高性能かつ高信頼性の薄膜半導体素子を良好な均一性で製造することができる。

【0105】また、この発明によれば、表面を清浄に保ったまま多結晶半導体薄膜の水素化を行うことができることにより、高性能の薄膜半導体素子を良好な均一性で製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施例において用いられるマルチチャンバー型の薄膜半導体素子製造装置を示す略線図である。

【図2】図1に示す薄膜半導体素子製造装置のCVD室の構成の一例を示す断面図である。

【図3】図1に示す薄膜半導体素子製造装置のレーザアニール室の構成の一例を示す断面図である。

【図4】この発明の第1実施例によるnチャネル多結晶Si TFTの製造方法を説明するための断面図である。

【図5】図4Bに示す状態に対応する平面図である。

【図6】図4Dに示す状態に対応する平面図である。

【図7】図4Gに示す状態に対応する平面図である。

【図8】図4Hに示す状態に対応する平面図である。

【図9】この発明の第2実施例によるnチャネル多結晶Si TFTの製造方法を説明するための断面図である。

【図10】図9Hに示す状態に対応する平面図である。

【図11】図9Jに示す状態に対応する平面図である。

【図12】大粒径の多結晶Si薄膜を形成する方法を説明するための断面図である。

【図13】この発明の第4実施例において用いられる薄膜半導体素子製造装置を示す略線図である。

【図14】この発明の第4実施例において熔融再結晶化およびプラズマ水素化を行うことにより形成された多結晶Si薄膜の暗伝導度および光伝導度のプラズマ水素化時の水素ガス圧力依存性の測定結果の一例を示すグラフである。

【図15】この発明の第4実施例において熔融再結晶化およびプラズマ水素化を行うことにより形成された多結晶Si薄膜の暗伝導度および光伝導度のプラズマ水素化時の水素化時間依存性の測定結果の一例を示すグラフである。

【図16】この発明の第5実施例において用いられる薄膜半導体素子製造装置を示す略線図である。

【図17】この発明の第6実施例において用いられる薄膜半導体素子製造装置を示す略線図である。

【図18】この発明の第7実施例において用いられる薄膜半導体素子製造装置を示す略線図である。

【図19】この発明の第8実施例において用いられる薄膜半導体素子製造装置を示す略線図である。

【図20】この発明の第9実施例によるpチャネル多結晶Si TFTの製造方法を説明するための断面図である。

【図21】この発明の第9実施例により製造されたpチャネル多結晶Si TFTのドレイン電流-ゲート電圧特性の測定結果の一例を示すグラフである。

【図22】レーザ光の照射によりa-Si:H薄膜の熔融再結晶化を行った後に一旦真空を破ってからプラズマ水素化を行うことにより形成された多結晶Si薄膜の暗伝導度および光伝導度のプラズマ水素化時の水素化時間依存性の測定結果の一例を示すグラフである。

【符号の説明】

C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub> CVD室

C<sub>3</sub> レーザアニール室

C<sub>4</sub> ロボット室

C<sub>5</sub> 水素化室

C<sub>6</sub> レーザアニールおよび水素化室

1 ガラスウェハー

2 a-Si:H、P薄膜

3 a-Si:H薄膜

L レーザ光

4 多結晶Si薄膜

4a 結晶粒

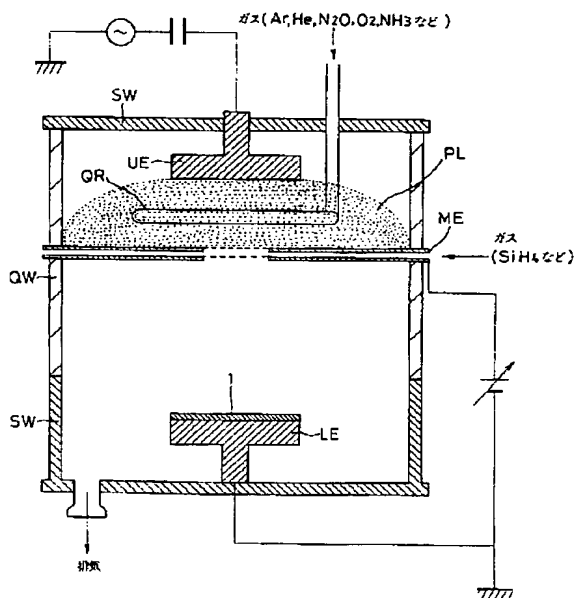
5 ソース領域

6 ドレイン領域

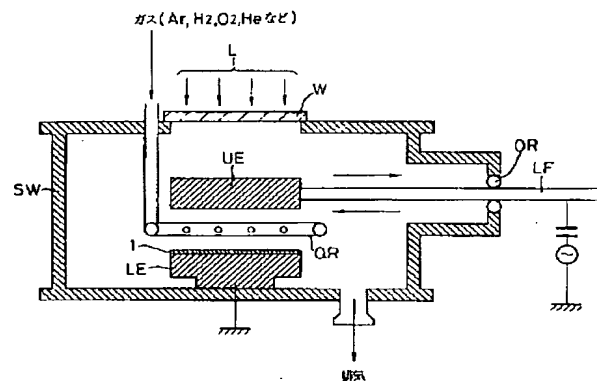
7 ゲート絶縁膜

13 a-Si:H、B薄膜

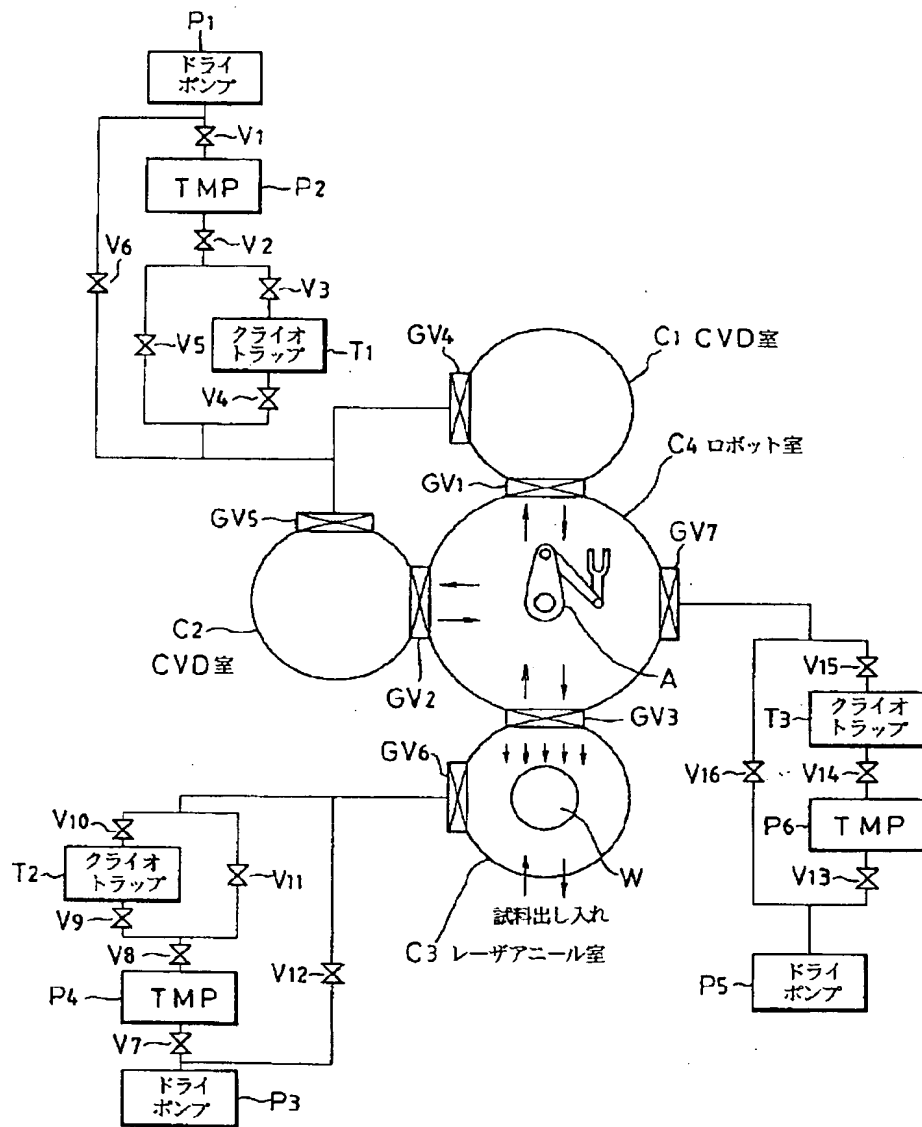
【図2】



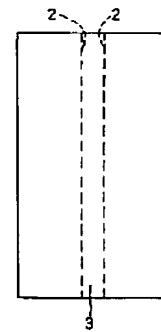
【図3】



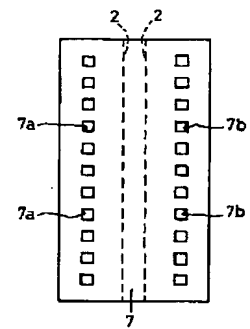
【図1】



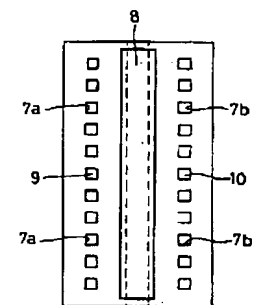
【図6】



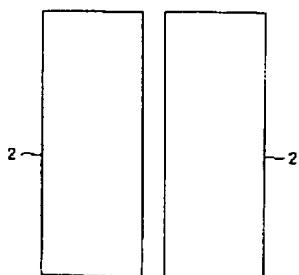
【図7】



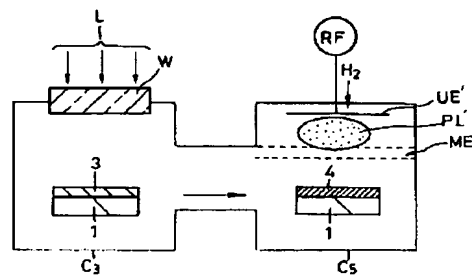
【図10】



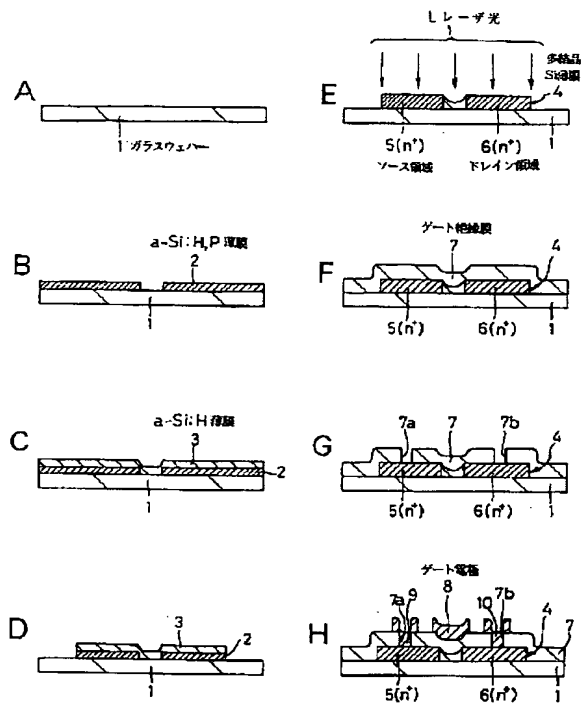
【図5】



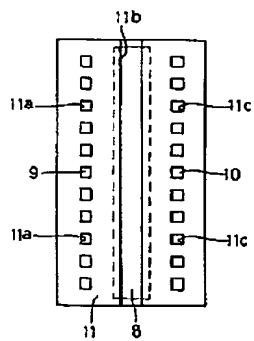
【図17】



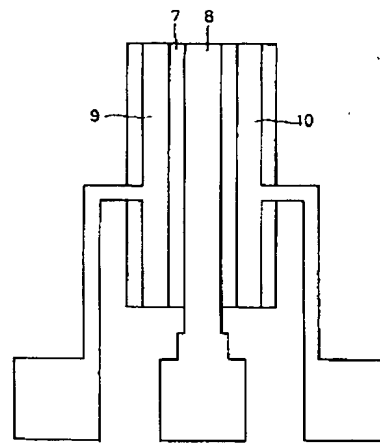
【図4】



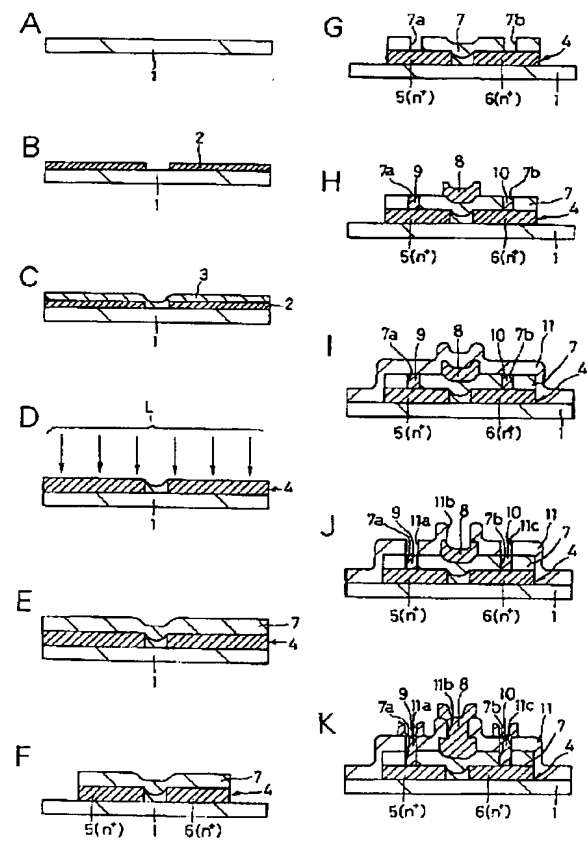
【図11】



【図8】

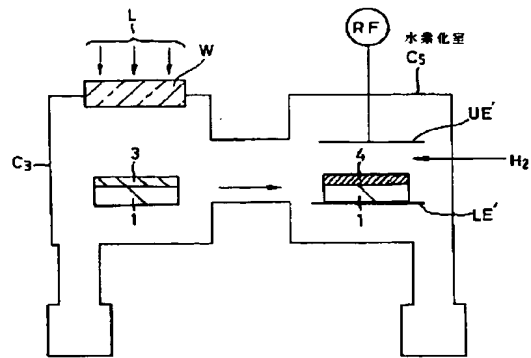


【図9】

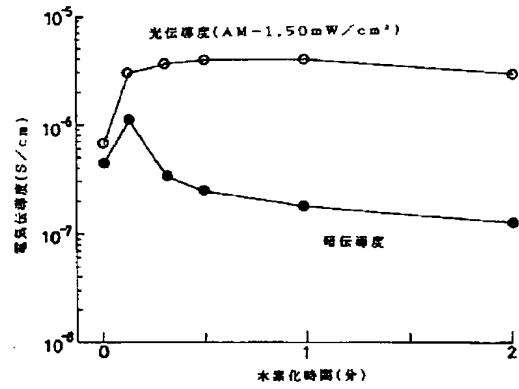




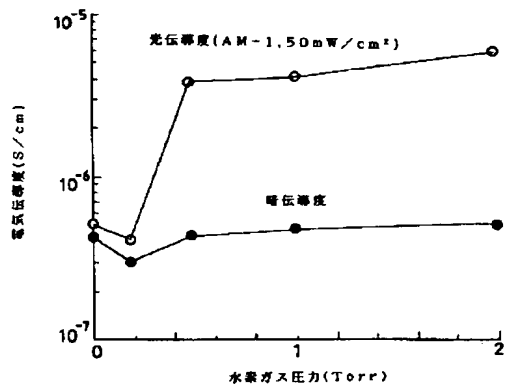
【圖 13】



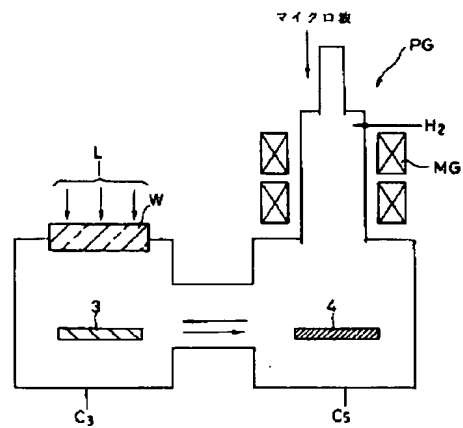
【図 15】



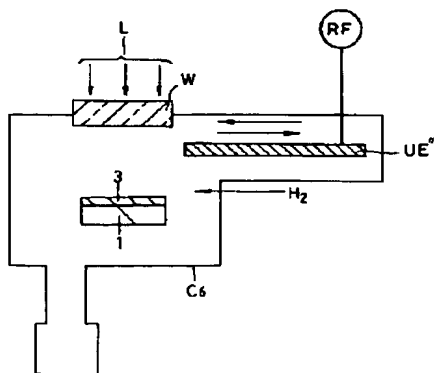
【図 14】



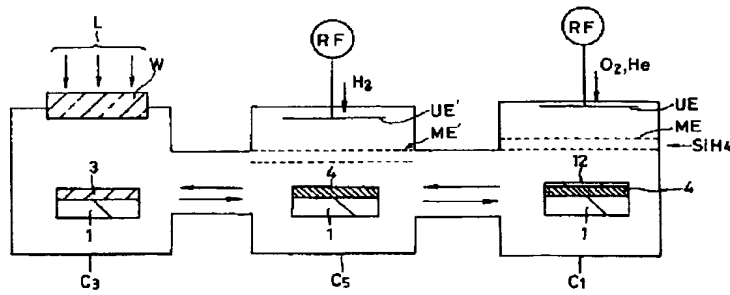
【圖 18】



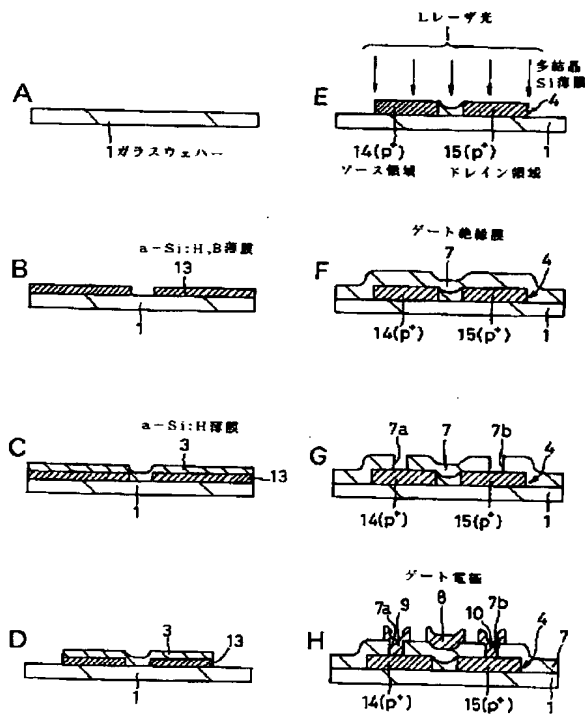
【図 16】



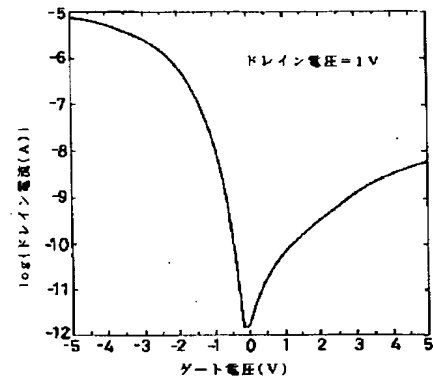
【図19】



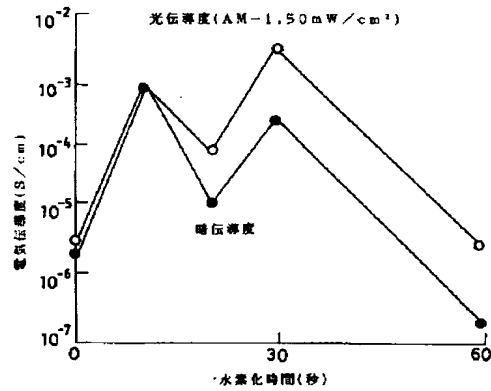
【図20】



【図21】



【図22】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>  
H01L 21/324  
21/336

識別記号 片内整理番号  
Z

F I

技術表示箇所

(72)発明者 香野 淳  
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ  
ー株式会社内

(72)発明者 関谷 光信  
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ  
ー株式会社内

(72)発明者 金谷 康弘  
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ  
ー株式会社内

(72)発明者 矢野 三千久  
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ  
ー株式会社内